

СПИНОВОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ СПЕКТРА ДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ,
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Ф.Т.Васько

Рассмотрено спиновое расщепление спектра двумерных электронов (таммовского состояния, квантованной пленки и инверсионного слоя), обусловленное взаимодействием с короткодействующим потенциалом поверхности. Расчет выполнен для изотропного приближения эффективной массы.

Динамика электрона проводимости ограниченного полупроводника описывается в $\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}$ -приближении уравнением

$$(\hat{\epsilon} + \hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}) \psi_{\lambda} = E_{\lambda} \psi_{\lambda}, \quad (1)$$

дополненным на короткодействующем (толщиной порядка постоянной решетки a) поверхностном потенциале граничными условиями для набора огибающих ψ_{λ} . Полная волновая функция электрона обычным образом [1] выражается через столбец ψ_{λ} . Граничное условие для ψ_{λ} получено ниже в приближении эффективной массы для идеальной поверхности (заданной уравнением $z = z_0$) из требования

$$\int d^2x \{ \psi_{\lambda}^{\dagger} \hat{v}_z \psi_{\nu} + (\hat{v}_z \psi_{\lambda})^{\dagger} \psi_{\nu} \} |_{z=z_0} = 0, \quad (2)$$

обеспечивающего самосопряженность задачи (1). Такой подход соответствует методу потенциала нулевого радиуса [2] и использовался при выводе бесспинового граничного условия [3]. В (1, 2) \mathbf{p} — оператор импульса, диагональная матрица $\hat{\epsilon}$ определяет положение экстремумов зон, $\hat{\mathbf{v}}$ — недиагональная по номеру зоны матрица скорости; эффективную массу m считаем малой по сравнению с массой свободного электрона.

Когда энергия E_{λ} близка к экстремуму зоны проводимости ϵ_c (ниже $\epsilon_c = 0$) и в многокомпонентной функции ψ_{λ} велик лишь спинор $\phi_{\lambda}^{(c)}$, гамильтониан в (1) преобразованием $\psi_{\lambda} = e^{\hat{S}} \phi_{\lambda}$ (явный вид оператора \hat{S} см. [1]) приводится к форме $p^2/2m$, а условие (2) оказывается зависящим от спина

$$\int d^2x \{ \phi_{\lambda}^{(c)\dagger} (p_z/m + \sum_i \hat{\beta}_{zi} p_i) \phi_{\nu}^{(c)} + [(p_z/m + \sum_i \hat{\beta}_{zi} p_i) \phi_{\lambda}^{(c)}]^{\dagger} \phi_{\nu}^{(c)} \} |_{z=z_0} = 0 \quad (3)$$

через тензор

$$\hat{\beta}_{zi} = \sum_n \frac{v_{cn}^z v_{nc}^i - v_{cn}^i v_{nc}^z}{\epsilon_c - \epsilon_n}. \quad (4)$$

Тензор (4), определяющий g -фактор электрона проводимости [1, 4], получается из антикоммутатора $\hat{v}_z \hat{S} + \hat{S} \hat{v}_z$, возникающего при подстановке разложения $\psi_\lambda = (1 + \hat{S}_\parallel) \phi_\lambda$ в (2). Компоненты (4) выражаются через спиновые матрицы

$$\beta_{zi} = \frac{\chi}{2m} (\sigma_z \sigma_i - \sigma_i \sigma_z), \quad (5)$$

причем коэффициент χ равен отношению спинового расщепления электронного спектра в магнитном поле к диамагнитному и мал в случае слабого спин-орбитального взаимодействия. Для кейновской модели зонного спектра в пределе большого спин-орбитального расщепления (такой случай реализуется в InSb) $\chi = 1/2$, а для дираковской модели (используемой при описании электронного спектра халькогенидов свинца [5] и висмута [6]) $\chi = 1$, т. е. в ряде материалов спиново-зависящее взаимодействие с поверхностью не мало.

В случае трансляционно-инвариантной поверхности $\phi_\lambda^{(c)} = \bar{\phi}_\lambda |p_\parallel\rangle$, где $|p_\parallel\rangle$ — двумерная плоская волна, а для зависящего от координаты z спинора ϕ_λ из (3) получается набор условий (p_\parallel и p_\parallel' — двумерные импульсы соответствующие состояниям λ и ν , e_z — орт вдоль оси OZ)

$$\delta_{p_\parallel p_\parallel'} \{ \bar{\phi}_\lambda^+ (p_z + i\chi \vec{\sigma} [e_z \times p_\parallel]) \bar{\phi}_\nu + [(p_z + i\chi \vec{\sigma} [e_z \times p_\parallel]) \bar{\phi}_\lambda]^+ \bar{\phi}_\nu \}_{z=z_0} = 0. \quad (6)$$

Диагонализуя (6) по спину [7] получаем $\bar{\phi}_\lambda = \exp[i\pi/4 (\sigma_x \cos \phi + \sigma_y \sin \phi)] \times \theta_\lambda | \Sigma \rangle$, где $p_\parallel = (p_\parallel \cos \phi, p_\parallel \sin \phi)$, $| \Sigma \rangle$ — собственная функция оператора σ_z ($\sigma_z | \Sigma \rangle = \Sigma | \Sigma \rangle$, квантовое число $\Sigma = \pm 1$ определяет проекцию спина на ось перпендикулярную p_\parallel). Скалярная функция θ_λ удовлетворяет уравнению $\frac{p_z^2}{2m} \theta_\lambda = \left(E_\lambda - \frac{p_\parallel^2}{2m} \right) \theta_\lambda$ с граничным условием для логарифмической производной на поверхности

$$(p_z + i\chi \Sigma p_\parallel + i p_0) \theta_\lambda |_{z=z_0} = 0. \quad (7)$$

При переходе от билинейной формы (6) к (7) аналогично [3] появится не зависящий от квантовых чисел λ ¹⁾ импульс p_0 , характеризующий свойства поверхности. Этот импульс здесь не связан явно с поверхностным потенциалом и должен определяться из экспериментальных данных.

Спиново-зависящее взаимодействие с плавным (на расстояниях порядка a) внешним полем имеет вид спин-орбитального слагаемого [8] и приводит к малым (по параметру \bar{E}/ϵ_g , \bar{E} — характерная энергия электрона проводимости, ϵ_g — ширина запрещенной зоны) эффектам. Принципиальное отличие (7) от результатов для плавного поля состоит в том,

¹⁾ Из-за фактора $\delta_{p_\parallel p_\parallel'}$ в (6) p_0 может зависеть от p_\parallel . Поскольку поверхностный потенциал короткодействующий, такая зависимость мала по параметру $p_\parallel a/\hbar$. Зависимость p_0 от Σ несущественна из-за инвариантности задачи относительно операции обращения времени при $p_\parallel = 0$.

что короткодействующий потенциал (аналогично постоянному магнитному полю) изменяет спиновое состояние электронов проводимости и в "нерелятивистском" предельном случае $\bar{E}/\epsilon \rightarrow 0$. Ниже находится спиновое расщепление спектра движущихся ($p_{\parallel} \neq 0$) электронов, локализованных у поверхности описываемой (7).

Решение для "мелкого" таммовского состояния на поверхности $z_0 = 0$ получим дополнив задачу граничным условием $\theta_{\lambda}|_{z \rightarrow +\infty} = 0$. Закон дисперсии таммовского состояния $E_{p_{\parallel}\Sigma}$ и глубина его локализации $K_{p_{\parallel}\Sigma}^{-1}$ ($\theta_{\lambda} \sim e^{-K_{p_{\parallel}\Sigma} z}$) даются формулами

$$E_{p_{\parallel}\Sigma} = - \frac{(\hbar K_{p_{\parallel}\Sigma})^2}{2m} + \frac{p_{\parallel}^2}{2m}, \quad \hbar K_{p_{\parallel}\Sigma} = p_0 + \chi \Sigma p_{\parallel}, \quad (8)$$

а область существования определяется условием $p_0 + \chi \Sigma p_{\parallel} > 0$. Полученный спектр (как и рассмотренные ниже) линеен при малых p_{\parallel} , что приводит (аналогично трехмерному случаю [9]) к возникновению петли экстремумов, которая велика при $\chi \sim 1$. Для дираковской модели спектр (8) линеен по p_{\parallel} ; переход на квадратичный спектр обеспечивается опущенным в (1) вкладом далеких зон.

При исследовании размерного квантования в пленке толщины d граничные условия (7) ставятся на обеих поверхностях (характерные импульсы обозначаем p_{\pm}). Закон дисперсии дается формулой $E_{\lambda} = [(\hbar K_{\lambda})^2 + p_{\parallel}^2] / 2m$, где K_{λ} определяется уравнением

$$\text{ctg } K_{\lambda} d = \frac{p_+ + p_- - (\chi p_{\parallel})^2 - \chi \Sigma p_{\parallel} (p_+ - p_-)}{\hbar K_{\lambda} (p_+ + p_-)} - \frac{\hbar K_{\lambda}}{p_+ + p_-}. \quad (9)$$

Когда правая часть (9) велика решения близки к квазиклассическим ($K_{\lambda} d \approx n\pi$) и слабо расщеплены по спину. Спиновое расщепление не мало лишь для области $\hbar K \sim \sqrt{p_+ p_-}$ (при малом p_{\parallel}), где не работает квазиклассическое приближение. Оценка величины $\Delta K = |K_{\Sigma=+1} - K_{\Sigma=-1}|$ получается в виде

$$\hbar \Delta K \sim \frac{\text{const}}{\bar{K} d} \chi p_{\parallel} \frac{p_+ - p_-}{p_+ + p_-} \quad (10)$$

причем для симметричной пленки расщепление отсутствует; в антисимметричном случае ($p_+ = -p_-$) решения всегда квазиклассические. Мнимый корень (9) описывает изменение спектра таммовского состояния в пленке.

Для электрона в инверсионном слое безразмерная энергия ϵ_{λ} ($\epsilon_{\lambda} = (E_{\lambda} - \frac{p_{\parallel}^2}{2m}) / \frac{(\hbar/l)^2}{2m}$, характерная длина l определена как $l^{-2} = \frac{2meE_s}{\hbar^3}$, $e < 0$, E_s — однородное приповерхностное поле) опреде-

ляется дисперсионным уравнением

$$\frac{p_0 + \chi \sum p_{\parallel}}{\hbar/l} Ai(-\epsilon_{\lambda}) - Ai'(-\epsilon_{\lambda}) = 0. \quad (11)$$

В квазиклассической области энергий $\epsilon_{\lambda} \gg 1$ использование асимптотики функции Эйри $Ai(x)$ позволяет оценить малое спиновое расщепление уровня

$$\Delta\epsilon \approx \frac{\text{const}}{\sqrt{\epsilon_{\lambda}}} \frac{\chi p_{\parallel}}{\hbar/l}. \text{ Для сильно связанного таммовского}$$

состояния $\epsilon_{\lambda} \ll -1$ получается результат (8). При $|\epsilon_{\lambda}| \sim 1$ порядок величины спинового расщепления определяется параметром $\chi p_{\parallel} / (\hbar/l)$.

Численное решение дисперсионных уравнений (9, 11) позволит рассчитать аналогичные [10] особенности спектров поглощения электромагнитного излучения, обусловленные спиновым расщеплением. Область

отрицательных эффективных масс $\left(\frac{d^2 E_{\lambda}}{dp_{\parallel}^2} < 0 \right)$ велика при большом

радиусе петли экстремумов. Поэтому в материалах с $\chi \sim 1$ возможны аномалии коллективных и кинетических эффектов на двумерных электронах.

Институт полупроводников
Академии наук Украинской ССР

Поступила редакцию
1 августа 1979 г.

Литература

- [1] J.M.Luttinger, W.Kohn. Phys. Rev., 97, 869, 1955; Дж. Каллуэй. Теория энергетической зонной структуры М., изд. Мир, 1969, гл. 4.
- [2] А.И.Базь, Я.Б.Зельдович, А.М.Переломов. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. М., изд. Наука, 1971, стр. 26, 513.
- [3] V.A.Volkov, T.N.Pinsker. Surf. Sci., 81, 181, 1979.
- [4] Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика, М., изд. Наука, 1978, § 59.
- [5] Yu.I.Ravich, B.A.Efimova, V.I.Tamarchenko. Phys. Stat. Sol., (b) 43, 11, 453, 1971.
- [6] Л.А.Фальковский. УФН, 94, 3, 1968.
- [7] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Квантовая механика, ФМ, 1963, § 58.
- [8] С.Т.Павлов, Ю.А.Фирсов. ФТТ, 9, 1780, 1967; В.Н.Абакумов, И.Н.Яс-сиевич. ЖЭТФ, 61, 2571, 1971.
- [9] Э.И.Рашба, В.И.Шека. ФТТ, 1, Сб. статей II, 162, 1959.
- [10] Ф.Т.Васько, Н.А.Прима. ФТТ, 21, 1734, 1979.